



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HBD435

对应国外型号
BD435

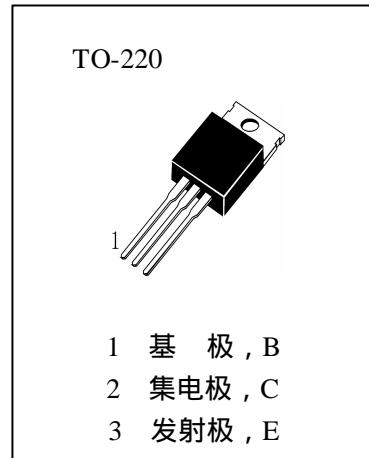
主要用途

中功率线性开关

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} —— 贮存温度	-65~150
T_j —— 结温	150
P_c —— 集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	40W
V_{CBO} —— 集电极—基极电压	32V
V_{CES} —— 集电极—发射极电压	32V
V_{CEO} —— 集电极—发射极电压	32V
V_{EBO} —— 发射极—基极电压	5V
I_c —— 集电极电流(DC)	4A
I_c —— 集电极电流(Pulse)	7A
I_B —— 基极电流	1A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_c=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	$V_{CB}=32\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$
I_{CES}	集电极—发射极截止电流			100	μA	$V_{CE}=32\text{V}, V_{BE}=0$
$h_{FE(1)}$	直流电流增益(1)	40	130			$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$
$*h_{FE(2)}$	直流电流增益(2)	85	140			$V_{CE}=1\text{V}, I_C=500\text{mA}$
$*h_{FE(3)}$	直流电流增益(3)	50				$V_{CE}=1\text{V}, I_C=2\text{A}$
$*V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		0.2	0.5	V	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$
$*V_{BE(ON)}$	基极—发射极通态电压			1.1	V	$I_C=2\text{A}, V_{CE}=1\text{V}$
$V_{CEO(SUS)}$	集电极—发射极维持电压	32			V	$I_C=100\text{mA}, I_B=0$
f_T	特征频率	3			MHz	$I_C=250\text{mA}, V_{CE}=1\text{V}$

*Pulse Test: PW=300 μs , Duty Cycle=1.5% Pulsed